

Bezugszeichenliste

- 100 integrierter Schaltkreis
- 101 Silizium-Substrat
- 102 Kontaktierungselement
- 103 erster Feldeffekttransistor
- 104 zweiter Feldeffekttransistor
- 105 Gate-Bereich
- 106 Gate-Bereich
- 200 erste Layout-Ansicht eines integrierten Schaltkreises
- 201 erster Feldeffekttransistor
- 202 zweiter Feldeffekttransistor
- 203 gemeinsame Gate-Leitung
- 203a erste Gate-Komponente
- 203b zweite Komponente
- 203c erste Verlaufsrichtung
- 203d zweite Verlaufsrichtung
- 203e dritte Verlaufsrichtung
- 203f vierte Verlaufsrichtung
- 204 aktives Gebiet
- 204a erste Verlaufsrichtung
- 204b zweite Verlaufsrichtung
- 205 aktives Gebiet
- 205a erste Verlaufsrichtung
- 205b zweite Verlaufsrichtung
- 206 erstes quadratisches Kontaktierungselement
- 207 zweites quadratisches Kontaktierungselement
- 208 drittes quadratisches Kontaktierungselement
- 300 zweite Layout-Ansicht eines integrierten Schaltkreises
- 301 erstes rechteckförmiges Kontaktierungselement
- 301a dritte Verlaufsrichtung
- 301b vierte Verlaufsrichtung
- 302 zweites rechteckförmiges Kontaktierungselement
- 302a dritte Verlaufsrichtung
- 302b vierte Verlaufsrichtung

303 drittes rechteckförmiges Kontaktierungselement

303a dritte Verlaufsrichtung

303b vierte Verlaufsrichtung

401 Lithographie-Einrichtung

405 Silizium-Wafer

406a prozessierte Chips

406b unprozessierte Chips

406c zu prozessierender Chip

407 Justieroptik

408 Retikel

409 Linse

410 Vorjustieroptik

411 Laserinterferometer

412 Spiegelfläche

413 xy-Tisch

414 Objektiv

415 Träger-Element

440 Flussdiagramm

450 erster Verfahrensschritt

455 zweiter Verfahrensschritt

460 dritter Verfahrensschritt

465 vierter Verfahrensschritt

470 fünfter Verfahrensschritt

475 sechster Verfahrensschritt